

Низкие динамические потери
 Малый заряд обратного восстановления
 Разветвленный управляющий электрод для
 высоких скоростей нарастания тока

Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ333-320-24

Средний прямой ток	I_{TAV}	320 A	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	U_{DRM}	2000 ÷ 2400 V	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}		
Время выключения	t_q	25.0; 32.0; 40.0 мкс	
U_{DRM} , U_{RRM} , V	2000	2200	2400
Класс по напряжению	20	22	24
T_j , °C		– 60 ÷ 125	

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

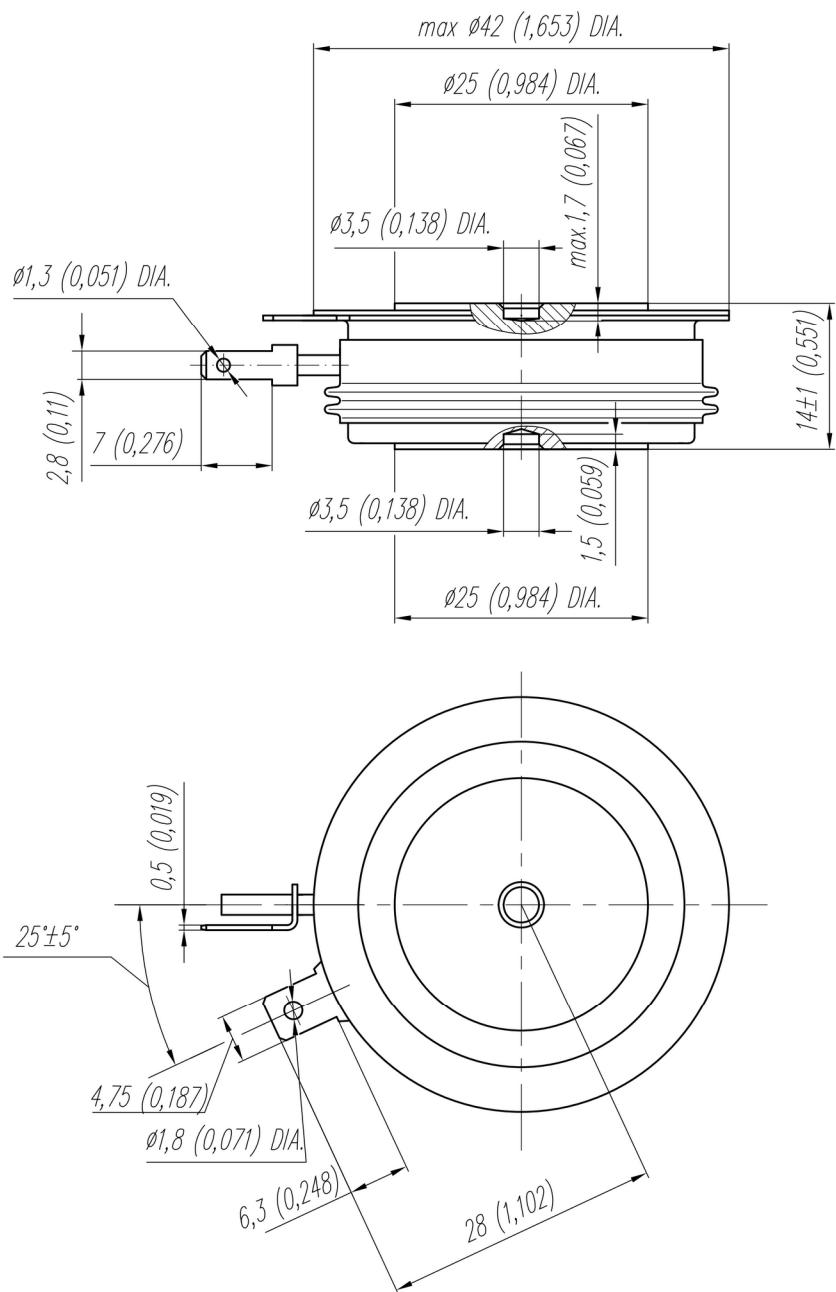
Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I_{TAV}	Средний ток в открытом состоянии	A	320 470	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=55$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TRMS}	Действующий ток в открытом состоянии	A	502	$T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	kA	6.3 7.2	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
			7.0 8.1	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
I^2t	Защитный фактор	$A^2\cdot 10^3$	198 259	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ($t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс
			200 270	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 60 Гц ($t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=I_{FGM}$; $U_G=20$ В; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt=1$ A/мкс

Блокирующие параметры				
U_{DRM}, U_{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2000÷2400	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
U_{DSM}, U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	2100÷2500	$T_{j\min} < T_j < T_{j\max}$; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
U_D, U_R	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	V	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\max}$; управление разомкнуто
Параметры управления				
I_{FGM}	Максимальный прямой ток управления	A	6	$T_j = T_{j\max}$
U_{RGM}	Максимальное обратное напряжение управления	V	5	
P_G	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ($f=1$ Hz)	A/мкс	1600	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$; $U_G = 20$ V; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ A/мкс
Тепловые параметры				
T_{stg}	Температура хранения	°C	- 60 ÷ 125	
T_j	Температура р-п перехода	°C	- 60 ÷ 125	
Механические параметры				
F	Монтажное усилие	кН	9.0÷11.0	
a	Ускорение	м/с ²	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
Характеристики в проводящем состоянии			
U_{TM}	V	2.60	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 1005$ A
$U_{T(to)}$	V	1.50	$T_j = T_{j\max}$;
r_T	МОм	1.25	$0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
I_H	mA	500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ V; управление разомкнуто
Блокирующие характеристики			
I_{DRM}, I_{RRM}	mA	50	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = U_{DRM}$; $U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	V/мкс	1000	$T_j = T_{j\max}$; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$; управление разомкнуто

Характеристики управления							
U _{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс		B	4.00 2.50 2.00	T _j =T _j min T _j =25 °C T _j =T _j max		
I _{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, макс		mA	500 300 200	T _j =T _j min T _j =25 °C T _j =T _j max		
U _{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин		B	0.25	T _j =T _j max; U _D =0.67U _{DRM} ;		
I _{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления, мин		mA	10.00	Постоянный ток управления		
Динамические характеристики							
t _{gd}	Время задержки включения		мкс	2.5	T _j =25 °C; V _D =0.4V _{DRM} ; I _{TM} =I _{TAV} ; Gate pulse: I _G =I _{FGM} ; V _G =20 V; t _{GP} =50 μs; di _G /dt=1 A/μs		
t _q	Время выключения ²⁾ , макс		мкс	25.0; 32.0; 40.0	dv _D /dt=50 В/мкс;		
				32.0; 40.0 50.0;	dv _D /dt=200 В/мкс;		
Q _{rr}	Заряд обратного восстановления, макс		мкКл	250	T _j =T _j max; I _{TM} =I _{TAV} ;		
t _{rr}	Время обратного восстановления, макс		мкс	4.0	di _R /dt=-50 A/мкс ; U _R =100 В		
I _{rrM}	Ток обратного восстановления, макс		A	130	U _R =100 В		
Тепловые характеристики							
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	°C/Вт		0.0500	Двухстороннее охлаждение		
R _{thjc-A}				0.1100	Охлаждение со стороны анода		
R _{thjc-K}				0.0900	Охлаждение со стороны катода		
R _{thck}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	°C/Вт	0.006	Постоянный ток			
Механические характеристики							
w	Масса, тип		г	110			
D _s	Длина пути тока утечки по поверхности		мм (дюйм)	10.30 (0.405)			
D _a	Длина пути тока утечки по воздуху		мм (дюйм)	6.30 (0.248)			
ПРИМЕЧАНИЕ			МАРКИРОВКА				
¹⁾ Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии			ТБИ 333 320 24 А2 М3 УХЛ2				
Обозначение группы			1 2 3 4 5 6 7				
(dv _D /dt) _{crit} , В/мкс			1. Быстродействующий импульсный тиристор				
			2. Конструктивное исполнение				
			3. Средний ток в открытом состоянии, А				
			4. Класс по напряжению				
			5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии				
			6. Группа по времени выключения (dv _D /dt=50 В/мкс)				
			7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т				
²⁾ Время выключения (dv _D /dt=50 В/мкс)							
Обозначение группы							
M3 K3 H3							
t _q , мкс							



Все размеры в миллиметрах (дюймах)